

**ЗАО «ЭПЛ»****ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ**124482, Москва, Зеленоград, а/я167, ЗАО «ЭПЛ». Тел./факс(495)532-81-95, т.(495)532-93-36
E-mail: epl@epl.ru, http://www.epl.ru**KE713**

АДБК432140.279ТУ

Мощный кремниевый транзистор

KE713 – N - канальный биполярный эпитаксиально-планарный транзистор с изолированным затвором (IGBT), изготовленный по канавочной (trench) технологии затвора.

Прибор предназначен для применения

в стробоскопических вспышках, драйверах мощных MOSFIT, в бытовой и прочей технике.

Отличительные особенности:

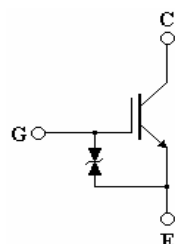
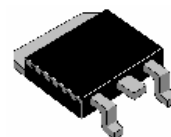
• высокая плотность ячеек • высокое входное сопротивление • низкое напряжение насыщения $V_{CE(sat)}=8\text{В}_{\text{макс.}}$; $I_C=150\text{А}$ • оптимальное управляющее напряжение на затворе 3,0В.

Аналог: GT5G131 (TOSHIBA), 4CC10KB (CHENMKO).

Выпускается

в пластмассовом корпусе КТ-89 (TO-252, D-Pak) – исполнение А9 и в бескорпусном исполнении – кристалле – исполнение А-5 для использования в составе гибридных схем.

КТ-89 (TO-252)

**Предельно-допустимые режимы эксплуатации.**

Параметры	Обозначение	KE713		Единицы измерения
		А9	А-5	
Напряжение коллектор-эмиттер	U_{CES}	400	400	В
Напряжение затвор-эмиттер пост / имп	U_{GES}	$\pm 6 / \pm 8$	$\pm 6 / \pm 8$	В
Ток коллектора постоянный	I_C	8	8	А
Ток коллектора импульсный (1мсек)	I_{cp}	150	150	А
Рассеиваемая мощность коллектора	P_D	20	1,3	Вт
Температура перехода	T_j	$-55 \div +150$	$-55 \div +150$	$^{\circ}\text{C}$

Электрические характеристики ($T_{\text{корп.}}=25^{\circ}\text{C}$)

Параметры		Обозначение	Режим	KE713 А9,А-5			Един. измер
				мин	тип	макс	
Ток утечки затвора		I_{GES}	$V_{GE}=6\text{В}, V_{CE}=0$	-	-	10	мкА
Ток отсечки коллектора		I_{CES}	$V_{CE}=400\text{В}, V_{GE}=0$	-	-	10	мкА
Напряжение отсечки затвор-эмиттер		$V_{GE(OFF)}$	$I_C=1\text{мА}, V_{CE}=5\text{В}$	0,5	-	2,5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер		$V_{CE(sat)}$	$I_C=130\text{А}, V_{GE}=3,0\text{В(импульс)}$	-	5	8	В
Входная емкость		C_{IES}	$V_{CE}=10\text{В}, V_{GE}=0, f=1\text{МГц}$	-	3500	-	пкФ
Времена переключения	Время нарастания	t_R		-	1,2	-	мкСек
	Время включения	t_{on}		-	1,4	-	
	Время спада	t_f		-	1,8	-	
	Время выключения	t_{off}		-	2,4	-	

“EPL” Semiconductor Devices Production124482, Moscow, Zelenograd, m/b167, “EPL Ltd”». Тел./факс(495)532-81-95, т.(495)532-93-36
E-mail: epl@epl.ru, http://www.epl.ru